

Изобретение относится к полупроводниковой технике и может быть использовано для детектирования магнитных и электромагнитных полей в современных электронных и оптоэлектронных системах.

Фотоэлектромагнитный датчик включает нанесенный на полуизолирующую полупроводниковую подложку активный полупроводниковый слой типа  $no(p\theta)$ , на котором нанесены омические контакты питания и контакты для регистрации напряжения Холла. На активном слое  $no(p\theta)$  локально нанесен полупроводниковый слой  $p+(n+)$ , на котором сформирован омический контакт с возможностью освещения слоя  $p+(n+)$ .

П. формулы: 1

Фиг.: 1